

專利權授權/讓與公告

公告主旨	有鑑於在面對市場、技術、產品的激烈競爭時，企業掌握優質專利可形成強有力的防護網，並可藉此累積企業技術能力，成為企業在國際間競爭的最佳籌碼；國立中央大學擬將其所擁有之優質專利，以授權或讓與方式提供國內廠商，以增加廠商國際競爭力及促進整體產業發展，並提升研發成果運用效益。歡迎各界洽詢。
公告時間	113年5月31日
公告內容	<p>一、申請資格：國內依中華民國法令組織登記成立之公司法人</p> <p>二、申請日期：即日起至113年8月31日17時00分止</p> <p>三、申請方式：請逕向本校研發處 智權技轉組 詢問相關資訊</p> <p>四、授權/讓與專利內容：詳見附件清單</p> <p>(專利技術內容請參考本校技術媒合網網頁介紹 http://ipm.ncu.edu.tw/prod.asp)</p>
聯絡人	研發處 產學營運中心智權技轉組李經理
聯絡電話	03-4227151 轉 27083
電子郵件	lizlee@ncu.edu.tw

序號	本校編號	專利名稱	申請號	國別	發明代表人
1	110013USL	Nonvolatile Memory Comprising Variable Capacitance Transistors and Method for Operating the Same	63/174,539	美國臨時案	謝易叡
2	110013TW	記憶體電路、記憶體裝置及其操作方法	111115307	中華民國	謝易叡
3	110013US	Memory Comprising Variable Capacitance Transistors and Method for Operating the Same	17/660,837	美國	謝易叡
4	110014USL	Three Dimensional Non-volatile Memory Circuit and Method for Operating the Same	63/177,389	美國臨時案	謝易叡
5	110014TW	記憶體電路、記憶體裝置及其操作方法	111121461	中華民國	謝易叡
6	110014CH	記憶體電路、記憶體裝置及其操作方法	202210650597.9	中國	謝易叡
7	110014US	MEMORY CIRCUIT, MEMORY DEVICE AND OPERATION METHOD THEREOF	17/806,080	美國	謝易叡
8	110014JP	記憶體電路、記憶體裝置及其操作方法	2022-093688	日本	謝易叡
9	110014DE	記憶體電路、記憶體裝置及其操作方法	102022114634	德國	謝易叡
10	111059USL	Dynamic Random Access Memory and Method for Operating the Same	63/380,745	美國臨時案	謝易叡
11	111059TW	記憶體電路、動態隨機存取記憶體及其操作方法	112134946	中華民國	謝易叡

12	111059US	MEMORY CIRCUIT, DYNAMIC RANDOM ACCESS MEMORY AND OPERATION METHOD THEREOF	18/485,324	美國	謝易叡
13	111059CH	記憶體電路、動態隨機存取記憶體及其操作方法	202311174326.1	中國	謝易叡
14	111059JP	MEMORY CIRCUIT, DYNAMIC RANDOM ACCESS MEMORY AND OPERATION METHOD THEREOF	2023-178860	日本	謝易叡
15	111059KR	MEMORY CIRCUIT, DYNAMIC RANDOM ACCESS MEMORY AND OPERATION METHOD THEREOF	10-2023-0142662	韓	謝易叡
16	111059EP	MEMORY CIRCUIT, DYNAMIC RANDOM ACCESS MEMORY AND OPERATION METHOD THEREOF	23203376.1	歐	謝易叡
17	111070USL	One-time Programmable Memory and Method for Operating the Same	63/387,692	美國臨時案	謝易叡
18	111070TW	單次編程記憶體電路、單次編程記憶體及其操作方法	112146137	中華民國	謝易叡
19	111070US	ONE-TIME PROGRAMMABLE MEMORY CIRCUIT, ONE-TIME PROGRAMMABLE MEMORY AND OPERATION METHOD THEREOF	18/539,622	美國	謝易叡
20	111070CH	單次編程記憶體電路、單次編程記憶體及其操作方法	202311615619.9	中國	謝易叡
21	111070JP	ONE-TIME PROGRAMMABLE MEMORY CIRCUIT, ONE-TIME PROGRAMMABLE MEMORY AND OPERATION METHOD THEREOF	2023-211262	日本	謝易叡
22	111070KR	ONE-TIME PROGRAMMABLE MEMORY CIRCUIT, ONE-TIME PROGRAMMABLE MEMORY AND OPERATION METHOD THEREOF	10-2023-0181408	韓	謝易叡
23	111070EP	ONE-TIME PROGRAMMABLE MEMORY CIRCUIT, ONE-TIME PROGRAMMABLE MEMORY AND OPERATION METHOD THEREOF	23217046.4	歐	謝易叡
24	112025USL	Ternary-content-addressable-memory and Method for Operating the Same	63/523,665	美國臨時案	謝易叡
25	112025TW	記憶體陣列電路、三元內容可定址記憶體及其操作方法	113120353	中華民國	謝易叡
26	112025US	記憶體陣列電路、三元內容可定址記憶體及其操作方法	專利申請中	美國	謝易叡
27	112025CH	記憶體陣列電路、三元內容可定址記憶體及其操作方法	專利申請中	中國	謝易叡
28	112063USL	Resistive Non-volatile Memory and Method for Operating the Same	63/615,268	美國臨時案	謝易叡
29	112063TW	Resistive Non-volatile Memory and Method for Operating the Same	專利申請中	中華民國	謝易叡
30	112063US	Resistive Non-volatile Memory and Method for Operating the Same	專利申請中	美國	謝易叡
31	112063CH	Resistive Non-volatile Memory and Method for Operating the Same	專利申請中	中國	謝易叡
32	112063JP	Resistive Non-volatile Memory and Method for Operating the Same	專利申請中	日本	謝易叡
33	112063KR	Resistive Non-volatile Memory and Method for Operating the Same	專利申請中	韓國	謝易叡
34	112063GB	Resistive Non-volatile Memory and Method for Operating the Same	專利申請中	英國	謝易叡
35	112063DE	Resistive Non-volatile Memory and Method for Operating the Same	專利申請中	德國	謝易叡